

Мощные GaN-транзисторы с подзатворной областью на основе МДП-структур

© Е.В. Ерофеев¹, И.В. Федин², В.В. Федина², М.В. Степаненко², А.В. Юрьева³

¹ Научно-исследовательский институт систем электрической связи
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники,
634034 Томск, Россия

² АО Научно-производственная фирма „Микран“,
634045 Томск, Россия

³ Физико-технический институт
Национального исследовательского Томского политехнического университета,
634050 Томск, Россия

E-mail: erofeev@micran.ru

(Получена 1 марта 2016 г. Принята к печати 10 марта 2017 г.)

Транзисторы с высокой подвижностью электронов на основе эпитаксиальных гетероструктур AlGaIn/GaN являются перспективной элементной базой для создания устройств силовой электроники следующего поколения. Это обусловлено как высокой подвижностью носителей заряда в канале транзистора, так и высокой электрической прочностью материала, позволяющей достичь высоких напряжений пробоя. Для применения в силовых коммутационных устройствах требуются нормально закрытые GaN-транзисторы, работающие в режиме обогащения. Для создания нормально закрытых GaN-транзисторов чаще всего используют подзатворную область на основе GaN *p*-типа, легированного магнием (*p*-GaN). Однако оптимизация толщины эпитаксиального слоя *p*-GaN и уровня легирования позволяет добиться порогового напряжения отпираания GaN-транзисторов, близкого к $V_{th} = +2$ В. В настоящей работе показано, что использование подзатворной МДП-структуры в составе *p*-GaN-транзистора приводит к увеличению порогового напряжения отпираания до $V_{th} = +6.8$ В, которое в широком диапазоне будет определяться толщиной подзатворного диэлектрика. Кроме того, установлено, что использование МДП-структуры приводит к уменьшению начального тока транзистора, а также затворного тока в открытом состоянии, что позволит уменьшить потери энергии при управлении мощными GaN-транзисторами.

DOI: 10.21883/FTP.2017.09.44895.8569

1. Введение

Появившись в середине 70-х годов прошлого века силовые MOSFET транзисторы на основе кремния (Si), благодаря большей скорости переключения и высокой эффективности по сравнению с биполярными транзисторами, стали повсеместно использоваться в силовой электронике: источниках питания, DC-DC преобразователях, контроллерах двигателей и пр. Однако сейчас, после непрерывного развития в течение более чем трех десятилетий, производительность Si MOSFET транзисторов достигла своего теоретического предела. Следующим шагом в развитии силовой электроники стало появление мощных транзисторов на основе нитрида галлия (GaN) [1].

Уникальные физические характеристики нитрида галлия в сравнении с кремнием позволяют достигнуть значительных улучшений в производительности: понижение сопротивления открытого канала, рост скоростей переключения, сохранение надежности при высоких уровнях температуры и радиации, уменьшение размеров упаковки. Возможность очень быстрого переключения практически без потерь, появляющаяся при использовании GaN-транзисторов, означает возможность увеличить эффективность и уменьшить размер преобразователя, а также уменьшить себестоимость его изготовления за

счет отказа от ряда дорогостоящих пассивных элементов (фильтров) схемы.

Для применения в силовой электронике необходимы нормально закрытые GaN-транзисторы, работающие в режиме обогащения. Для создания нормально закрытых GaN-транзисторов чаще всего используют подзатворную область на основе GaN *p*-типа, легированного магнием (*p*-GaN) [2,3].

При этом пороговое напряжение отпираания транзистора с подзатворной областью на основе *p*-GaN определяется главным образом толщиной эпитаксиального слоя *p*-GaN и уровнем его легирования. Оптимизация данных параметров позволяет добиться порогового напряжения отпираания GaN-транзисторов, близкого к $V_{th} = +2$ В. При этом максимально допустимое значение напряжения на затворе *p*-GaN-транзистора составляет всего $V_{gs\ max} = 6$ В, что делает их не совместимыми с работой типовых драйверов управления кремниевых MOSFET транзисторов, у которых уровень управляющего сигнала на выходе может достигать $V_{gs} = 15$ В. Таким образом, актуальной является задача по повышению порогового напряжения отпираания силовых GaN-транзисторов с подзатворной областью на основе *p*-GaN, а также увеличению максимально допустимого напряжения на затворе.

Известно, что нормально закрытые GaN-транзисторы могут быть получены при использовании рессеца (уто-

нения) барьерного слоя AlGaIn с последующим формированием подзатворной МДП-области на основе тонких пленок Al_2O_3 или Si_xN_y диэлектриков [4–7], сформированных методами плазмохимического или атомно-слоевого осаждения (ALD). К преимуществам таких транзисторов можно отнести высокое пороговое напряжение отпираания, близкое к $V_{th} = +5$ В, а также высокое значение максимального допустимого напряжения на затворе транзистора ($V_{gs} > 10$ В). Однако данные транзисторы характеризуются недостаточно высокой надежностью их работы, что обусловлено наличием дефектов травления на границе раздела диэлектрик/тонкий барьерный слой на основе AlGaIn [8–10].

Цель настоящей работы заключается в исследовании электрических характеристик мощных GaN-транзисторов с подзатворной МДП-областью при использовании p -GaN/AlGaIn/GaN-структур.

2. Методики эксперимента

В экспериментах использовались эпитаксиальные гетероструктуры типа p -GaN/AlGaIn/GaN, выращенные методом металлоорганической газофазовой эпитаксии на подложках кремния Si диаметром 100 мм. Гетероструктура включала в себя буферный слой на основе легированного железом GaN толщиной 2 мкм, каналный слой GaN, барьерный слой $Al_{0.25}Ga_{0.75}N$ толщиной 10 нм и p -GaN-слой, легированный магнием. Толщина p -GaN слоя составляла 50 нм, концентрация атомов магния определялась вторичной ионной масс спектроскопией и составляла $5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$.

На начальной стадии на поверхность пластин методом плазмохимического осаждения производилось осаждение тонких пленок диэлектрика на основе нитрида кремния (Si_3N_4) с толщинами 0.5, 10 и 15 нм. Далее литографическими методами производилось формирование рисунка затворной металлизации с последующим осаждением пленок палладия (Pd) толщиной 100 нм методом электронно-лучевого испарения в вакууме. Методом плазмохимического травления производилось удаление пленки SiN с поверхности пластин при использовании твердой маски на основе пленки палладия. Далее по Pd-маске производилось селективное плазмохимическое травление p -GaN-слоя в плазме состава BCl_3/SF_6 с целью формирования самосовмещенной подзатворной p -GaN области. После формирования межприборной изоляции на пластине производилось формирование низкотемпературных (550°C) омических контактов на основе композиции Ta/Al к областям стока и стока транзистора. Далее на поверхность пластин производилось плазмохимическое осаждение защитного диэлектрика на основе пленок нитрида кремния толщиной 170 нм.

Длина и ширина затвора GaN-транзистора составляла 1 и 100 мкм соответственно. Расстояния затвор–исток и затвор–сток составляли 1 и 6 мкм.

Электрические параметры GaN-транзисторов по постоянному току исследовались с помощью измерителя характеристик полупроводниковых приборов HP4156A.

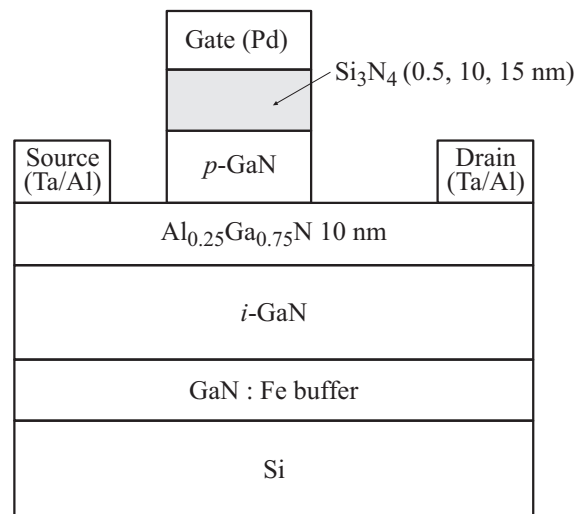


Рис. 1. Схематическое изображение изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур.

На рис. 1 представлено схематическое изображение изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур.

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 2 представлены стоковые передаточные характеристики ($I_{ds} - V_{gs}$) изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур. Транзистор, изготовленный классическим способом с затвором на основе барьера Шоттки, демонстрирует нормально закрытый режим работы со значением порогового напряжения отпираания

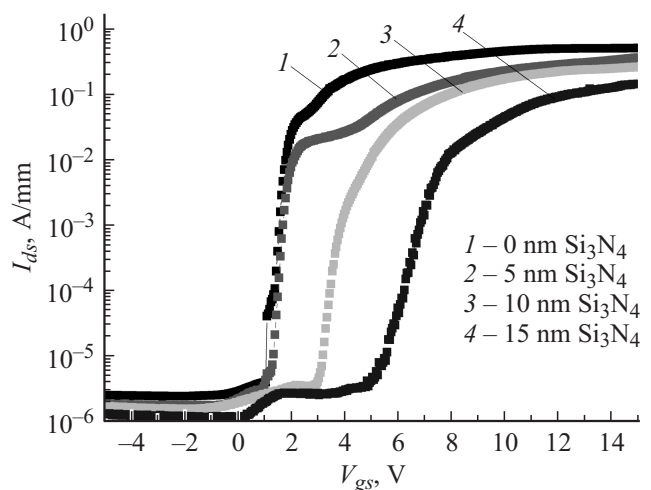


Рис. 2. Стоковые передаточные характеристики ($I_{ds} - V_{gs}$) изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур.

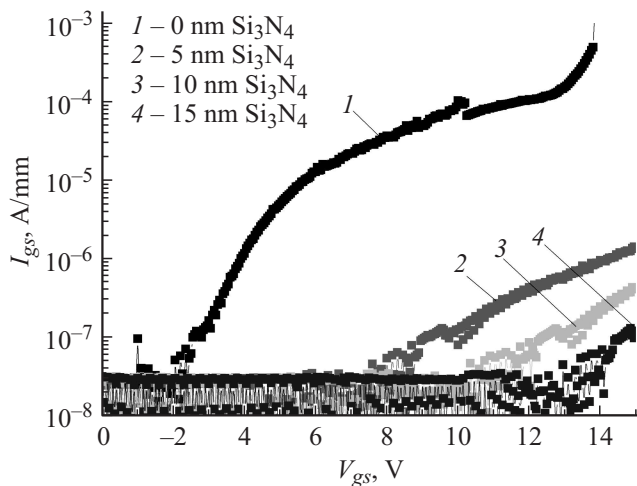


Рис. 3. Затворные передаточные характеристики ($I_{gs}-V_{gs}$) изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур.

$V_{th} = +1.5$ В и начального тока стока $I_{dso} = 3$ мкА/мм при $V_{gs} = 0$ В. Величина максимального тока стока транзистора составляет $I_{ds} = 0.52$ А/мм при $V_{gs} = 15$ В. Из результатов, представленных на рис. 2, видно, что GaN-транзисторы с подзатворной областью на основе МДП-структур с толщинами диэлектрика 5, 10 и 15 нм демонстрируют значения порогового напряжения $V_{th} = +1.7, +3.8, +6.8$ В соответственно. При этом увеличение толщины подзатворного диэлектрика приводит к снижению начального тока-стока транзистора в закрытом состоянии, что может быть обусловлено снижением плотности поверхностных состояний на границе раздела SiN/p-GaN в результате процесса пассивации. Следует отметить, что транзисторы с подзатворной МДП-областью с толщиной диэлектрика 15 нм демонстрируют меньшую величину максимального тока стока транзистора $I_{ds} = 0.25$ А/мм при $V_{gs} = 15$ В.

На рис. 3 представлены затворные передаточные характеристики ($I_{gs}-V_{gs}$) изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур. Транзистор, изготовленный классическим способом с затвором на основе барьера Шоттки, характеризуется большой величиной затворного тока $I_{gs} = 20$ мкА/мм при $V_{gs} = 6$ В. Из результатов, представленных на рис. 3, видно, что осаждение тонкой пленки диэлектрика (5 нм) на подзатворную p-GaN область транзистора приводит к значительному снижению затворного тока транзистора в открытом состоянии, а также увеличению диапазона максимального рабочего напряжения затвор-исток до $V_{gs} = 12-15$ В. При этом увеличение толщины пленки подзатворного диэлектрика до 15 нм приводит к дальнейшему уменьшению тока затвор-исток до уровня $I_{gs} = 0.1$ мкА/мм при $V_{gs} = 15$ В.

На рис. 4 представлены экспериментальные зависимости порогового напряжения отпираания транзистора, с подзатворной МДП-областью, а также его максимального тока стока от толщины подзатворного диэлектрика.

Данные рис. 4 свидетельствуют о том, что увеличение толщины подзатворного диэлектрика с 0 до 15 нм приводит к росту величины порогового напряжения отпираания транзистора с $V_{th} = +1.5$ В до $V_{th} = +6.8$ В. При этом наблюдается линейное уменьшение максимального тока стока транзистора.

На рис. 5 представлена эквивалентная схема изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур. Известно, что слой p-GaN, легированный магнием на поверхности барьерного слоя на основе AlGaIn, а также каналный слой i-GaN-транзистора, представляют собой p-i-n-диод, который открывается подаче положительного смещения на затвор. Барьер Шоттки на поверхности p-GaN является обратно смещенным по отношению к p-i-n-диоду на

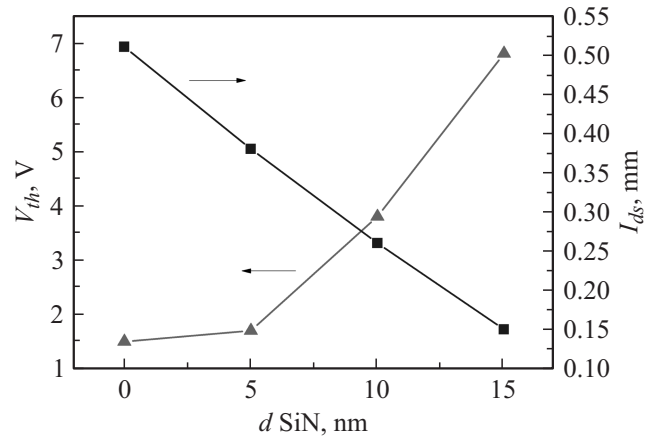


Рис. 4. Экспериментальные зависимости порогового напряжения отпираания GaN-транзистора, с подзатворной МДП-областью, а также его максимального тока стока от толщины подзатворного диэлектрика.

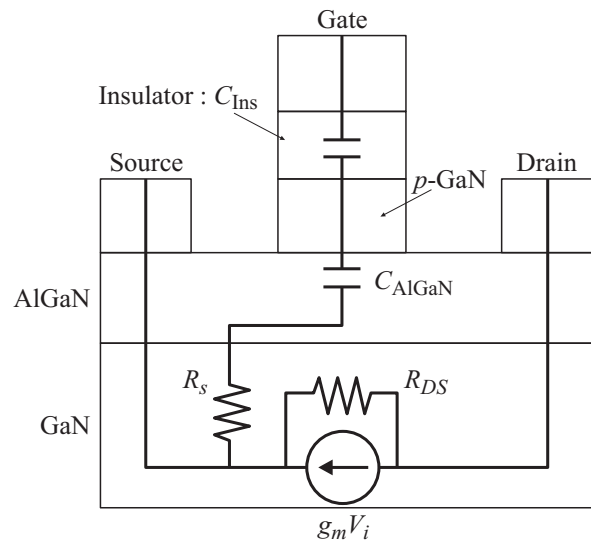


Рис. 5. Эквивалентная схема изготовленного мощного GaN-транзистора с подзатворной областью на основе МДП-структур.

основе p -GaN/AlGaN/GaN. При этом пороговое напряжение отпираания такой структуры определяется емкостью барьерного слоя на основе AlGaN. Введение в состав транзистора подзатворного диэлектрика приводит к увеличению суммарной емкости подзатворной МДП-области, что и приводит к росту порогового напряжения отпираания мощного GaN-транзистора.

4. Заключение

Мощные GaN-транзисторы на основе эпитаксиальных гетероструктур AlGaN/GaN, работающие в режиме обогащения, являются перспективной элементной базой для создания устройств силовой электроники следующего поколения. Для получения нормально закрытых GaN-транзисторов чаще всего используется подзатворная область на основе p -GaN слоя. При этом оптимизация его толщины и уровня легирования позволяет достичь величины порогового напряжения отпираания транзистора $V_{th} = +2$ В.

В данной работе показано, что использование подзатворной МДП-структуры в составе p -GaN-транзистора приводит к увеличению порогового напряжения отпираания до $V_{th} = +6.8$ В. При этом данное значение в широком диапазоне будет определяться толщиной подзатворного диэлектрика. Кроме того, установлено, что использование МДП-структуры приводит к уменьшению начального тока GaN-транзистора, а также затворного тока в открытом состоянии, что позволит уменьшить потери энергии при управлении мощными GaN-транзисторами.

Авторы работы выражают благодарность коллективу Научно-производственного комплекса „Микроэлектроника“ АО Научно-производственной фирмы „Микран“ и коллективу Научно-образовательного центра „Нанотехнологии“ Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники за содействие в проведении экспериментальной части работы и обсуждении результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение № 14.577.21.0204 от 27.10.15). Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57715X0204.

Список литературы

- [1] D. Marcon, B. De Jaeger, S. Halder, N. Vranckx, G. Mannaert, M. Van Hove, D. Decoutere. *IEEE Trans. Semicond. Manufacturing*, **26**, 3 (2013).
- [2] O. Hilt, A. Knauer, F. Brunner, J. Würfl. *Proc. 22nd Int. Symp. on Power Semiconductor Devices and ICs* (Hiroshima, Japan, March 16–18, 2010).
- [3] Y. Uemoto, M. Hikita, H. Ueno, H. Matsuo, H. Ishida, M. Yanagihara, T. Ueda, D. Ueda, T. Tanaka. *IEEE Trans. Electron. Dev.*, **54**, 7 (2007).
- [4] Woojin Choi, Ogyun Seok, Hojin Ryu, Ho-Young Cha, Kwang-Seok Seo. *IEEE Electron Dev. Lett.*, **35**, 2 (2014).
- [5] D. Bisi, M. Meneghini, M. Van Hove, D. Marcon, S. Stoffels, T. Wu, S. Decoutere, G. Meneghesso, E. Zanoni. *Phys. Status Solidi A*, **212**, 1122 (2015).
- [6] P. Lagger, C. Ostermaier, D. Pobegen, D. Pogany. *Proc. IEEE Int. Electron Devices Meeting (IEDM)*, 13.1 (2012).
- [7] D.V. Kiseleva, Y.N. Yurjev, Y.V. Petrakov, D.V. Sidelev, D.V. Korzhenko, E.V. Erofeev. *J. Phys.: Conf. Ser.*, **789**, 012028 (2017).
- [8] P. Lagger, M. Reiner, D. Pogany, C. Ostermaier. *IEEE Electron Dev.*, **61**, 4 (2014).
- [9] M. Meneghini, I. Rossetto, D. Bisi, M. Ruzzarin, M. Van Ho, S. Stoffels, T.-KiWu, D. Marcon, S. Decoutere, G. Meneghesso, E. Zanoni. *IEEE Electron Dev. Lett.*, **37**, 12 (2016).
- [10] T. Wu, D. Marcon, B. De Jaeger, M. Van Hove, B. Bakeroot, S. Stoffels, G. Groeseneken, S. Decoutere, R. Roelofs. *Proc. IEEE Int. Reliability Physics Symp.* (Monterey, CA, USA, 2015).

Редактор Г.А. Оганесян

High voltage MIS-gated GaN transistors

E.V. Erofeev¹, I.V. Fedin¹, V.V. Fedina²,
M.V. Stepanenko², A.V. Yuryeva³

- ¹ Research Institute of Electrical Communication Systems of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 634050 Tomsk, Russia
- ² Research & Production Company Micran, 634041 Tomsk, Russia
- ³ Physical Technical Institute of National Research Tomsk Polytechnic University, 634050 Tomsk, Russia

Abstract E -mode AlGaN/GaN HEMTs are generally promising candidate for switching power transistors due to their high breakdown voltage, high current density and low on-resistance. The threshold voltage (V_{th}) of normally-off mode AlGaN/GaN HEMTs with a self-aligned p -type GaN gate can be successfully improved by inserting a SiN insulator between the p -GaN and a Schottky gate electrode. The V_{th} can be increased from +1.5 V to +6.8 V by inserting of 15 nm SiN layer. Moreover, the sub-threshold drain and on-state gate currents of p -gate GaN transistor were decreased.